1 мкм, тогда как образец (рисунок 4б) имеет мозаичную структуру. Размер мозаики 1 – 3 мкм.



Рисунок 5. Электронные снимки АОП полученных на постоянном токе в щавелевой кислоте: А – при плотности тока 1 А/дм², Б – 2 А/дм² и увеличениях в 1000^X (верхние снимки) и 10000^X (нижние снимки)

На рисунке 5а и 5б представлены электронные снимки пленок, сформированных в свежеприготовленном растворе H₂C₂O₄ на постоянном токе при разных плотностях, равных 1 А/дм² и 2 А/дм². Оба образца характеризуются однородной шероховатой поверхностью, но различаются размером включений непроанодированного алюминия: у первого они достигают размеров 1 мкм, а у второго ~ 0,01 – 0,1 мкм. Сказывается влияние величины плотности тока анодирования.

На пленках, полученных на постоянном токе явно выражена анизотропность поверхности, тогда как у пленок сформированных на переменном токе она незначительна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состав, структура и свойства анодных оксидов алюминия отличаются друг от друга и определяются многими факторами. Это обстоятельство должно учитываться при использовании данного материала на практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Yang S.G., et al. // Phys. Lett. A. 2003. 318, № 4–5
- Ведерников А.П. Изоляция оксидных пленок алюминия – Казань: ЦБТИ, 1959. – С. 91-93.
- F. Paulik, J. Paulic, L. Erdey // Z. anal. Chem., 1958. – V. 160. – P. 241.
- Компанеец Е.Ю. Взаимодействие с водой анодного оксида. Диссерт. канд. хим. наук. – Барнаул. - 1980. – 190 с.
- А.В. Вихарев, В.И. Верещагин, А.А. Вихарев, И.Н. Заезжаева, Л.Ю. Макаренко // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2004. -№4. – С. 104-107.

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Mn₅Si₃, Mn₅Ge₃ и Mn₅(Ge₁-xSix)₃ В СЕРНОКИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

А.Б.Шеин

В работе изложены результаты исследования коррозионно- электрохимического поведения Mn_5Si_3 , Mn_5Ge_3 , а также соединений типа $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$ в сернокислом электролите. Показано, что анодная стойкость германида марганца в сернокислом электролите существенно ниже, чем силицида марганца, что связано с меньшей стойкостью Ge в сравнении с Si, и лучшей растворимостью оксидов германия. Соединения $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$ характеризуются сложным электрохимическим поведением, при анализе которого следует учитывать такие внутренние факторы процесса, как состав поверхностных слоев и появление связи Ge-Si в соединениях.

Поиск и разработка новых коррозионностойких материалов приводит к необходимости исследования ранее не изученных в коррозионном аспекте сплавов и, в частности, интерметаллических и металлоподобных соединений. Отсутствие единых теоретических концепций, позволяющих прогнозировать электрохимические характеристики таких материалов, исходя из их качественного и количественного состава, серьезно сдерживает быстрое развитие данной области электрохимического материаловедения. Ранее нами подробно исследовано электрохимическое поведение силицидов и германидов марганца в кислых электролитах [1-3], и показано, что анодный процесс на этих электродах протекает селективно и характеризуется преимущественной ионизацией металлического компонента.

Представляет интерес исследовать более сложные, многокомпонентные объекты – соединения типа $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$.

Физические характеристики этих соединений описаны в [4,5], а их электрохимические свойства ранее не изучались.

Цель работы – исследовать коррозионно-электрохимическое поведение, а также кинетику парциальных электродных процессов на $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$, где x = 0.05 – 0.9 в сернокислом электролите.

Изготовление образцов $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$, подготовка электродов к исследованиям, методики электрохимических измерений аналогичны использованным ранее [1-3]. Поляризационные потенциостатические и циклические (скорость развертки потенциала v = 5 мB[·]c⁻¹) кривые снимали с помощью потенциостата ПИ-50-1. Рабочий раствор – 0.5 М H₂SO₄. Значения потенциала Е в работе приведены к стандартной водородной шкале.

Потенциостатические поляризационные кривые (ПК) для Si, Ge, Mn_5Si_3 , Mn_5Ge_3 , а также для $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$, полученные в 0.5М H_2SO_4 , представлены на рисунке 1, результаты их обработки – в таблице 1. Видно (рисунок 1,а), что скорость катодного процесса возрастает с увеличением количества Si в соединениях, исключение составляет сам Mn_5Si_3 , при этом катодные ПК многокомпонентных электродов всё больше походят на катодную ПК Si, как по величине Тафелева наклона b_k , так и по значениям плотности катодных токов i_k .

Известно, что потенциал коррозии марганца Екор ≈ -1.0 В. Лимитирующей стадией реакции выделения водорода на Mn является, вероятно, разряд ионов H₃O⁺. Высокое значение b_к на Si, очевидно, связано с окисленностью поверхности электрода даже при сильно отрицательных Е. Катодная ПК Ge имеет характерный излом. Эффект снижения перенапряжения при низких плотностях тока обусловлен изменением состояния поверхности Ge-электрода, а именно, прохождением через точку нулевого заряда. При малых поляризациях, одновременно с выделением водорода, продолжается саморастворение Ge, при больших поляризациях наблюдается одновременное выделение водорода и образование GeH₄. Порядок катодной реакции n

на Mn₅Si₃ равен 0.61 [3]. Дробное значение n может быть, по-видимому, связано с тем, что выделение водорода на силициде марганца реализуется по разным маршрутам на металлической и неметаллической компонентах соединения. Особенности катодного поведения Mn₅Ge₃, вероятно, определяются металлическим компонентом, при этом n = 0,81. По-видимому, на Mn₅Ge₃, как и на Mn, лимитирующей стадией катодного процесса является разряд ионов H₃O⁺. Вместе с тем, при Е более положительных, чем потенциал коррозии Mn, участок катодной ПК для Mn₅Ge₃ напоминает катодную ПК для чистого Ge. При Е, более отрицательных, чем Е_{кор} Mn, наклон катодной ветви ПК для Mn₅Ge₃ уменьшается, катодные токи увеличиваются, стремясь к значениям і_к, характерным для Mn.



Рисунок 1. Катодные (а) и анодные (б) потенциостатические поляризационные кривые, полученные в 0.5М H₂SO₄: 1 - Si, 2 - Mn₅Si₃, 3

 $- Mn_5Ge_{0.60}Si_{2.40}, 4 - Mn_5Ge_{2.40}Si_{0.60}, 5 - Mn_5Ge_{2.55}Si_{0.45}, 6 - Mn_5Ge_{2.85}Si_{0.15}, 7 - Mn_5Ge_{3}, 8 - Ge, 9 - Mn_5Ge_{0.30}Si_{2.70}$

Все вышеперечисленные факторы могут оказать влияние на реакцию выделения во-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2009

дорода на $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$, которая протекает с разной скоростью на атомах компонент, составляющих соединения.

Таблица 1

Кинетические параметры электрохимических процессов на Mn, Ge, Si, Mn_5Si_3 , $Mn_5Ge_3 u$ $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3 в 0.5M H_2SO_4$

Электрод	Е _{кор} , В	i _{кор} ,	b _k , B	b _a , B
		A/m^2		
Mn	-0.677	34.70	0.146	0.060
Ge	-0.062	$1.24^{-10^{-2}}$	0.144	0.096
Si	-0.077	$5.62^{-10^{-2}}$	0.151	0.110
Mn ₅ Ge ₃	-0,112	0.224	0.173	0.069
Mn5Ge2.85Si0.15	-0.162	$2.69^{-10^{-2}}$	0.191	0.062
Mn5Ge2.55Si0.45	-0.302	0.759	0.163	0.079
Mn5Ge2.40Si0.60	-0.322	0.288	0.160	0.120
Mn5Ge0.60Si2.40	-0.152	3.63 ⁻ 10 ⁻²	0.147	0.139
Mn ₅ Si ₃	-0.297	$1.57 \cdot 10^{-2}$	0.127	0.153

Потенциалы коррозии соединений $Mn_5Ge_{2.55}Si_{0.45}$ и $Mn_5Ge_{2.4}Si_{0.6}$ имеют значения близкие к $E_{\text{кор}}$ для Mn_5Si_3 , хотя ток коррозии этих сплавов больше, чем $i_{\text{кор}}$ силицида марганца.

Скорость анодного растворения марганца высока: плотность анодного тока (i_a) в диапазоне $\Delta E = -0.6...+2.0$ В равна $1.3^{\circ}10^{\circ}$ А/м². В то же время анодное растворение кремния происходит со скоростью меньшей ~ на 3 порядка величины і_а, нежели растворение марганца, а значение Екор для Si ~ -0.1 В. Согласно литературным данным [7], равновесный потенциал чистой неокисленной поверхности кремния в кислой среде Е = -0.86 В, но в обычных условиях из-за присутствия оксидной пленки потенциал коррозии кремния равен -0.1 В. Германий растворяется при анодной поляризации значительно сильнее, чем кремний, но слабее, чем марганец [3]. Еще более существенное понижение іа наблюдается для силицида марганца. Скорость анодного растворения Mn₅Si₃ ~ на 4 порядка ниже, чем скорость растворения Mn и ~ на 2 порядка ниже, чем і_а для Si [3]. Гермарганца обладает существенно манид меньшей анодной стойкостью в сравнении с силицидом (рисунок 1,б) и, кроме того, при анодной поляризации он растворяется лучше, чем чистый германий, но медленнее, чем марганец.

Резкое различие в анодном поведении марганца и его силицида вряд ли обусловлено простым повышением прочности связи Mn-Si в сравнении с Mn-Mn. Очевидно, оно также связано с различными механизмами их растворения. Стандартный потенциал марганца $E^{\,\rm o}_{\,\,Mn^{2+}/Mn}$ = -1.18 В, а его пассивация не наблюдается в области потенциалов ∆Е = -1.18...+1.40 В при рН = 0 – 1. Согласно [7], в этой области Е марганец растворяется с образованием Mn²⁺. По данным работы [8], при значениях Е ≥ 0,6 В образуются оксиды марганца, которые не обладают значительной плотностью, чтобы пассивировать Mn. Указывается на возможность образования на Mn многофазных пленок с увеличением или уменьшением степени окисления марганца уже после их образования. Это, в частности, осложняет достижение воспроизводимости результатов при изучении растворения марганца в различных средах. При наличии на поверхности электрода пористой пленки электролит соприкасается через поры не только с рядом оксидов различного состава, но и с металлом, и говорить в данном случае об одном потенциалопределяющем процессе, по мнению автора [8], трудно.

В той же области потенциалов кремний находится в окисленном состоянии соответственно возможным реакциям:

Si + 2 H₂O - SiO₂ + 4 H⁺ + 4 e; E° = -0.857 B Si + 3 H₂O = H₂SiO₃ + 4 H⁺ + 4 e; E° = -0.840 B.

Кремний обладает большим сродством к кислороду. Существование оксидной пленки можно обнаружить даже после анодной поляризации Si-электрода в растворе HF, в котором пленка хорошо растворима.

В случае силицида марганца Mn₅Si₃ имеет место селективное растворение марганца из подрешетки в металлоподобном соединении, сопровождаемое окислением кремния до SiO₂. В таком случае растворение Mn может контролироваться как его диффузией в сплаве, так и диффузией его окисленной формы в порах поверхностного слоя, состоящего из SiO₂. Причем, чем выше содержание Si в сплавах с металлами, тем более компактные и плотные пленки образуются на поверхности.

Механизм растворения Mn₅Ge₃, повидимому, иной, чем Mn₅Si₃. При анодной поляризации в исследуемой области потенциалов германий образует оксиды GeO и GeO₂. Оксид GeO₂ малоустойчив и способен растворяться уже в H₂O. Оксид GeO более стоек, однако его растворимость, конечно, существенно выше, нежели диоксида кремния. По данным работы [7], образующаяся на поверхности Ge-электрода в процессе анодной поляризации оксидная пленка не обладает пассивирующими свойствами и не тормозит реакцию анодного растворения до тех пор, пока не возникнут затруднения с удале-

нием продуктов реакции от поверхности электрода. Согласно [9], при окислении Ge при Е = 0.15 – 0.35 В на поверхности происходит электрохимическая адсорбция кислорода (1-13 монослоев в зависимости от Е и времени окисления). Окисление при E ≥ 0.35 В приводит к дополнительному образованию монослоя оксида GeO. При E ≥0.57 В на поверхности германия образуются толстые слои фазового оксида, которые не восстанавливаются полностью при катодной поляризации. Вследствие более высокой стойкости SiO₂ силицид Mn₅Si₃ обладает большим химическим сопротивлением в кислотах по сравнению с германидом Mn₅Ge₃. При анодной поляризации Mn₅Ge₃ в раствор переходят оба компонента соединения (в отличие от Mn₅Si₃), правда, с различными скоростями (германий растворяется медленнее марганца). С этим связан тот факт, что анодные токи для Mn₅Ge₃ ниже, чем для Mn, но выше, чем для Ge.

Таким образом, при анодном растворении $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$ следует учитывать селективную ионизацию Mn при достаточно отрицательных потенциалах, а также возможность образования на поверхности смеси оксидов Si и Ge, один из которых является достаточно растворимым, а другой (SiO₂) – уникально стойким в кислых средах.

Анодная ПК Mn₅Ge_{0.3}Si_{2.7} располагается в области потенциалов, характерных для ПК Si, а до 0.6 В повторяет ход кривой Mn₅Si₃. Такое поведение этого соединения, вероятно, обусловлено атомами Si. C уменьшением в решетке сплава Ge-Si числа атомов Ge по мере замещения его кремнием, связи Ge-Ge постепенно превращаются в связи Ge-Si, причем возможно появление и связей Si-Si. При дальнейшем анодном растворении (E>0.6 B) Mn₅Ge_{0.3}Si_{2.7} большой вклад в процесс вносят атомы Ge. Вид ПК для других исследуемых многокомпонентных соединений с меньшим содержанием Si напоминает скорее кривую анодного растворения Ge, что подтверждает значительную роль атомов германия в анодном процессе на исследуемых сплавах.

Из результатов, приведенных на рисунке 1,б, следует, что наибольшей анодной стойкостью обладает Mn_5Si_3 . Замена атомов Si на атомы Ge вызывает, как правило, рост i_a, а анодные ПК соединений показывают сложную зависимость Igi от E. Так анодная стойкость $Mn_5Ge_{0.30}Si_{2.70}$ уменьшается приблизительно на 2 порядка, а $Mn_5Ge_{0.60}Si_{2.40}$ - на 3 порядка по сравнению с Mn_5Si_3 . Такое повышение i_a характерно для сплавов с содержа-

нием 1.88%, 5.62%, 7.50% атомов Si вплоть до потенциала приблизительно равного 0.6 В, при котором происходит образование GeO₂ и его химическое растворение (в случае чистого германия). Вследствие более низких значений Е_{кор} соединений Mn₅Ge_{2.55}Si_{0.45} и Mn₅Ge_{2.55}Si_{0.45} по сравнению с Е_{кор} Si и Ge , на начальной стадии анодного процесса происходит селективное растворение атомов Mn из соединений. Далее анодные кривые соединений совпадают с анодной ПК германида марганца, при этом фиксируются значения плотности токов, приблизительно равные 1000 А/м². При E>1.2 В на всех кривых исследуемых сплавов, за исключением Mn₅Si₃, наблюдаются осцилляции тока, скорее всего, процессами связанные С пассивациидепассивации поверхности сплавов оксидами Ge.

Исследование анодного процесса методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) показало, что для Mn₅Si₃ анодный пик тока практически вырождается уже на 4-5 циклах. Данные результаты согласуются с предположением о селективном растворении марганца и обеднении им поверхностных слоев сплава.

ЦВА-кривые прямого и обратного хода для Mn и Ge различаются слабо, что доказывает отсутствие пассивации данных материалов в сернокислом электролите, а величины ia во всех циклах намного выше, чем для Si и Mn₅Si₃. Наиболее сложную форму имеют ЦВА-кривые для Mn₅Ge₃. Вслед за участком, характеризующимся малыми i_a, на кривых наблюдается заметный рост значений плотности анодного тока, а начиная с E > 1,2 В, фиксируются осцилляции тока, связанные, возможно, С процессами образованияразрушения оксидных пленок. На участках кривых обратного ходя значения ia также остаются достаточно высокими. С увеличением № цикла анодные токи уменьшаются в значительно меньшей степени, чем для силицида марганца.

Метод циклической вольтамперометрии позволяет установить появление осцилляций тока при E > 1.2B для Mn₅Ge_{2.4}Si_{0.6} (рисунок 2).

Значение тока для первого пика в случае $Mn_5Ge_{0.6}Si_{2.4}$ существенно уменьшается по сравнению с Mn_5Ge_3 , а на втором цикле этот пик совсем исчезает. На ЦВА кривой для Mn_5Si_3 анодный пик при этих же потенциалах не наблюдается. Очевидно, анодный пик при $E \approx 0.2$ -0.3 В объясняется ионизацией атомов Ge в соединениях. С этим же связано возникновение осцилляций тока на кривых прямого и обратного хода для многокопонентных со-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2009

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Mn_5Si_3 , Mn_5Ge_3 и $Mn_5(Ge_{1-x}Si_x)_3$ В СЕРНОКИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

единений с малым содержанием Si (1.88%, 5.62%, 7.50%), подобных таковым для Mn_5Ge_3 . На ЦВА-кривой соединения с 30% атомов Si ($Mn_5Ge_{0.6}Si_{2.4}$) осцилляции тока едва заметны только в первом цикле, а в последующих циклах они вырождаются (рисунок 2), а для Mn_5Si_3 такие осцилляции тока вообще не характерны.



Рисунок 2. Первые циклы циклических вольтамперных кривых соединений, полученные в 0.5M H₂SO₄ при скорости развёртки 5 мB/с: 1 -Mn₅Ge₃, 2 - Mn₅Ge_{2.85}Si_{0.15}, 3 - Mn₅Ge_{2.55}Si_{0.45}, 4 - Mn₅Ge_{2.40}Si_{0.60}, 5 - Mn₅Ge_{0.60}Si_{2.40}



Рисунок 3. Хроноамперометрические кривые в 1
н H_2SO_4 : 1 - $Mn_5Ge_{0.60}Si_{2.40},$ 2 - $Mn_5Ge_3,$ 3 -
 $Mn_5Ge_{2.85}Si_{0.15},$ 4 - $Mn_5Ge_{2.40}Si_{0.60},$ 5 -
 $Mn_5Ge_{2.55}Si_{0.45}$

Электрохимическое поведение исследуемых многокомпонентных соединений изучали также хроноамперометрическим методом. Из полученных зависимостей плотности тока от времени при Е=1.33 В (рисунок 3), видно, что на начальной стадии Mn₅Ge_{2.85}Si_{0.15}, также как и Mn₅Ge₃, растворяется равномерно (ia не зависит от t), хотя значения іа выше для тройного соединения. Mn₅Ge_{2.55}Si_{0.45}, Mn₅Ge₂₄Si₀₆ Для И Mn₅Ge_{0.6}Si_{2.4} при малых t наблюдается зависимость і от t, причем і_а для Mn₅Ge_{0.6}Si_{2.4} ниже чем і_а для Mn₅Ge₃, а для первых двух соеди-ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2009

нений - выше. Через 100 секунд с начала анодного процесса скорость растворения соединений падает. При больших значениях t i,t^{-1/2} - кривые для всех соединений стремятся к нулю. Это является показателем селективного растворения Mn по механизму нестационарной объёмной диффузии при больших t. Падение плотности тока во времени обусловлено также образованием продуктов коррозии и уменьшением доли свободной поверхности, на которой протекают процессы окисления.

Титриметрическим методом было определено содержание Mn в растворе 0,5M H₂SO₄ после анодной поляризации при E=1.33 B.

Результаты показали, что количество Мп, перешедшего в раствор в результате анодной поляризации соединений Mn₅Ge_{2.85}Si_{0.15}, Mn₅Ge_{2.55}Si_{0.45}, Mn₅Ge_{2.4}Si_{0.6} и Mn₅Ge₃, остаётся практически неизменным. Скорее всего, как и в случае германида марганца, при данном потенциале основным процессом являются электрохимические и химические превращения Ge и его оксидов, а атомы Mn селективно растворяются по типу твёрдофазной диффузии. Количества Mn в сернокислом растворе существенно уменьшаются с ростом Si в сплаве до 30%.

Поведение тройных соединений с небольшим содержанием Si $(Mn_5Ge_{2.85}Si_{0.15}, Mn_5Ge_{2.55}Si_{0.45}, Mn_5Ge_{2.4}Si_{0.6})$ в области потенциалов начала анодного растворения (до E \approx 0.6 B), скорее всего, объясняется появлением новой связи Ge-Si.

Анодная стойкость германида марганца в сернокислом электролите существенно ниже, чем силицидов марганца, что связано с меньшей стойкостью Ge в сравнении с Si, и лучшей растворимостью оксидов германия, так как существенную роль здесь играет степень локализации валентных электронов Si и Ge и образование стабильных sp³ - конфигураций, которые у Ge энергетически менее устойчивы, чем у Si.

Таким образом, многокомпонентные соединения Mn₅(Ge_{1-x}Si_x)₃ характеризуются сложным электрохимическим поведением, при анализе которого следует учитывать такие внутренние факторы процесса, как: шероховатость, состав поверхностных слоев, а также появление связи Ge-Si в соединениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой программы Минобразования РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Бояринцева Е.Н., Шеин А.Б. // Журн. прикл. химии. 2000. Т. 73. № 11. С. 1840-1842.
- 2. Шеин А.Б., Зубова Е.Н. // Защита металлов. 2005. Т. 41. № 3. С. 258-266.
- 3. Шеин А.Б., Зубова Е.Н. // Электрохимия. 2004. Т. 40. №2.С. 222-227.
- Panissod P., Qachaqu A., Kappel G. // J.Phys.C.: Solid State Phys. 1984. Vol. 17. № 32. P. 5799-5810.
- 5. Kappel G., Fischer G., and Jae'gle' A. // Phys. Status Solidi (a). 1976. Vol. 34. P. 691-696.

- Жураковский Е.А., Францевич И.Н. Рентгеновские спектры и электронная структура силицидов и германидов. - Киев: Наук. думка. 1981. - 319с.
- Справочник химика / Под ред. Никольского Б.П. Л.: Химия. 1964. Т.3. 1006 с.
- Агладзе Р.И. Коррозия марганца и его сплавов // Труды 3-го Междунар. конгресса по коррозии металлов. М.: Мир. 1968. Т.1. С.244-256.
- Ефимов А.И., Белорукова Л.П., Василькова И.В., Чечев В.П. Свойства неорганических соединений: Справочник. Л.: Химия. 1983. - 392 с.

ВЛИЯНИЕ ОКСИДОВ И ХЛОРИДОВ МЕТАЛЛОВ НА ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ

В.Н. Попок, В.Н. Хмелев

В статье представлены результаты исследования влияния оксидов и хлоридов металлов на параметры горения и термического разложения энергетических конденсированных систем на основе бесхлорного окислителя нитрата аммония.

ВВЕДЕНИЕ

Как показано в литературе [1-4], одной из важнейших проблем, сдерживающих применение нитрата аммония (НА) в смесевых энергетических материалах (ЭМ), является низкая эффективность горения как самого НА, так и топливных систем на его основе. Под низкой эффективностью горения понимают низкие значения скорости и температуры горения, а также, как следствие, высокие значения энергомассовых потерь на агломерацию и шлакообразование при горении металлизированных ЭМ на основе НА.

Одним из эффективных путей решения рассматриваемых проблем является применение в смесях ЭМ на основе НА катализаторов термического разложения и горения. Выбор катализаторов горения и термического разложения смесевых материалов является достаточно сложной проблемой, которую в общем случае необходимо связывать с физико-химическими особенностями этих процессов. Непосредственное применение данных по катализу горения и разложения индивидуальных соединений зачастую оказывается невозможным применительно к гетерогенным смесям на их основе. В качестве примера такой ситуации можно привести результаты А.П. Глазковой [3], показавшей, что такой самый эффективный катализатор разложения и горения нитрата аммония как бихромат калия, в смесевых гетерогенных композициях сохраняет свою эффективность только в смесях ЭМ на основе нитроэфирных горючихсвязующих.

Специфической особенностью НА и ЭМ на его основе является существование расплавленного слоя НА на поверхности горящих образцов, что облегчает образование как сажистого слоя в окрестности поверхности горения, так и накопление частиц катализатора в этой области и возможность перевода некоторых из катализаторов в растворенное состояние в расплаве НА, что существенно изменяет параметры каталитической эффективности. При выборе конкретных классов катализаторов для анализа их каталитической эффективности в настоящей работе руководствовались как литературными данными, в основном изложенными в работах А.П. Глазковой и Г.Б. Манелиса с сотрудниками [2, 3], так и результатами качественной теории катализа [5]. Кроме этого, принималось во внимание, что некоторые катализаторы могут участвовать в обменных процессах с алюминием (например, хлорид олова (II)) при сопутствующем растворении окисной пленки на